

2SB710, 2SB710A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

一般増幅用 / General Amplifier

2SD602, 2SD602A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SD602, 2SD602A

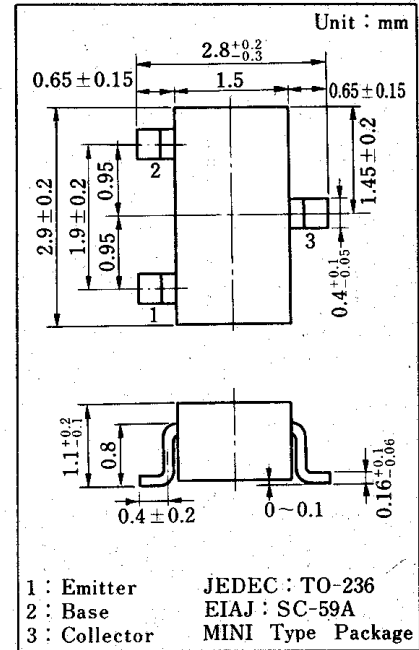
■ 特徴 / Features

- コレクタ電流 I_C が大きい。 / Large I_C
- ミニ型パッケージのため機器の小形化およびテーピング、マガジン包装による自動挿入が可能。

MINI Type package suitable for small equipment, tape and magazine types for automatic insertion are available.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-25	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-1	A
コレクタ電流	I_C	-500	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20\text{ V}, I_E = 0$			-0.1	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	$I_C = -10\ \mu\text{A}, I_E = 0$	-30			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	$I_C = -10\ \text{mA}, I_B = 0$	-25			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	$I_E = -10\ \mu\text{A}, I_C = 0$	-5			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	$V_{CE} = -10\ \text{V}, I_C = -150\ \text{mA}^{*2}$	85		340	
	h_{FE2}	$V_{CE} = -10\ \text{V}, I_C = -500\ \text{mA}^{*2}$	40			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -300\ \text{mA}, I_B = -30\ \text{mA}^{*2}$		-0.35	-0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -300\ \text{mA}, I_B = -30\ \text{mA}^{*2}$		-1.1	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -10\ \text{V}, I_E = 50\ \text{mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\ \text{V}, I_E = 0, f = 1\ \text{MHz}$		6	15	pF

*2 パルス測定 / Pulse Test

*1 h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	Q	R	S
h_{FE1}	85 ~ 170	120 ~ 240	170 ~ 340
Marking Symbol	CQ	CR	CS
	DQ	DR	DS

■ 形名表示記号(例) / Marking Symbol

